Monatshefte für Chemie Chemical Monthly

© by Springer-Verlag 1982

Ternäre Thalliumchalkogenide mit Tl₄Ge₂S₆-Struktur

Günther Eulenberger

Institut für Chemie, Universität Hohenheim, D-7000 Stuttgart 70, Bundesrepublik Deutschland

(Eingegangen 9. November 1981. Angenommen 4. Januar 1982)

Ternary Thallium Chalcogenides with Tl₄Ge₂S₆ Structure

The new ternary thallium chalcogenides $Tl_4Si_2S_6$, $Tl_4Si_2Se_6$, and $Tl_4Ge_2Se_6$ were synthetized from the elements. The compounds crystallize in the triclinic system (space group P $\overline{1}$) with the cell parameters $\alpha=6.699\,(5)$, $b=6.645\,(4)$, $c=8.380\,(5)$ Å, $\alpha=90.32\,(5)$, $\beta=112.00\,(5)$, $\gamma=112.32\,(5)^\circ$ for $Tl_4Si_2S_6$, $\alpha=6.875\,(2)$, $b=6.866\,(2)$, $c=8.731\,(2)$ Å, $\alpha=90.50\,(2)$, $\beta=111.69\,(2)$, $\gamma=113.70\,(2)^\circ$ for $Tl_4Si_2Se_6$, $\alpha=6.925\,(6)$, $b=6.934\,(7)$, $c=8.771\,(6)$ Å, $\alpha=90.55\,(7)$, $\beta=111.42\,(6)$, $\gamma=114.45\,(7)$ for $Tl_4Ge_2Se_6$ and Z=1 for all cases. On the basis of single crystal X-ray intensity data the compounds were shown to be isostructural with $Tl_4Ge_2S_6^{-1}$. The crystal structures of $Tl_4Si_2S_6$, $Tl_4Si_2Se_6$, and $Tl_4Ge_2Se_6$ are characterized by anions $[Si_2S_6]^{4-}$, $[Si_2Se_6]^{4-}$, and $[Ge_2Se_6]^{4-}$ which consist of two tetrahedral SiS4, SiSe4, and GeSe4 groups, respectively, with a common edge. A short comparative discussion of dinuclear tetrahedral thio- and selenoanions of main group elements is given.

[Keywords: Crystal Structure; Thallium chalcogenides; Thallium(I) seleno-germanate; Thallium(I) selenosilicate; Thallium(I) thiosilicate]

Einleitung

Präparative und strukturchemische Untersuchungen im System Tl_2S — GeS_2^2 führten unter anderem zur Darstellung der Verbindung $Tl_4Ge_2S_6$, die einen neuen ternären Strukturtyp repräsentiert, dessen Bauelemente Tl^+ -Ionen und isolierte $[Ge_2S_6]^{4-}$ -Anionen darstellen 1 . Die Ge_2S_6 -Baueinheit besteht aus zwei über eine gemeinsame Kante verknüpften GeS_4 -Tetraedern. Im Zusammenhang mit der weiteren Charakterisierung des $Tl_4Ge_2S_6$ -Typs erhob sich die Frage, wieweit Germanium durch die übrigen Elemente der 4. Hauptgruppe und Schwefel durch Selen ersetzbar ist.

Experimentelles

Zur Darstellung von Tl₄Si₂S₆, Tl₄Si₂Se₆ und Tl₄Ge₂Se₆ wurde von stöchiometrischen Gemengen der Elemente ausgegangen, die in evakuierten und abgeschmolzenen Quarzglasampullen einer thermischen Behandlung ausgesetzt wurden. Der Ansatz entsprechend Tl₄Si₂S₆ wurde zunächst zwei Wochen bei 300 °C, anschließend zwei Wochen bei 450 °C getempert, wobei ein homogenes, weitgehend kristallines gelbbraunes Reaktionsprodukt anfiel. Zur Darstellung des tiefroten Tl₄Si₂Se₆ wurde der entsprechende Ansatz zunächst acht Tage bei 600—700 °C im Schmelzfluß gehalten, in zwei Tagen auf 300 °C abgekühlt und acht Tage bei dieser Temperatur gehalten. Im Falle des tiefschwarzen, schwach metallglänzenden Tl₄Ge₂Se₆ wurde der Ansatz fünf Tage bei 500 °C in der Schmelze homogenisiert, sodann langsam auf Raumtemperatur abgekühlt.

Aus den Reaktionsprodukten konnten für die Röntgenstrukturanalyse geeignete Einkristalle der neuen Verbindungen isoliert werden, die auf einem Syntex-P 2_1 -Vierkreis-Einkristalldiffraktometer vermessen wurden. Die für $Tl_4Si_2S_6$, $Tl_4Si_2S_6$ aud $Tl_4Ge_2S_6$ erhaltenen triklinen Elementarzellen sind der von $Tl_4Ge_2S_6^1$ ähnlich, wodurch Isotypie der neuen Verbindungen mit $Tl_4Ge_2S_6$ nahegelegt wurde. Die Gitterkonstanten wurden nach Zentrierung von je 20 bis 24 Reflexen hoher Intensität im Bereich $21 \le 20 \le 41^\circ$ nach der Methode der kleinsten Fehlerquadrate verfeinert (Tab. 1). Anschließend wurden die Reflex-

Tabelle 1. Kristallographische Daten der Verbindungen Tl₄Si₂Se₆, Tl₄Si₂Se₆ und Tl₄Ge₂Se₆

Strukturtyp		${ m Tl_4Ge_2S_6\text{-}Typ}$	
Raumgruppe		$P\overline{1}, Z=1$	
Verbindung	$Tl_4Si_2S_6$	$\mathrm{Tl_4Si_2Se_6}$	$\mathrm{Tl_4Ge_2Se_6}$
a [Å]	6,699(5)	6,875(2)	6,925(6)
b	$6{,}645(4)$	6,866(2)	6,934(7)
c	8,380(5)	8,731(2)	8,771 (6)
α [°]	90,32(5)	90,50(2)	90,55(7)
β	112,00(5)	111,69(2)	111,42(6)
Ϋ́	112,32(5)	113,70(2)	114,45(7)
V [Å ³]	315,2	344,6	$350,\!4$
D_x [gcm ⁻³]	$5,\!62$	$6,\!49$	6,81
$\mu (\mathrm{MoK} \alpha) [\mathrm{cm}^{-1}]$	524,1	641,0	673,2

intensitäten in ω -Abtastung im Bereich $2 \le 20 \le 54^\circ$ gemessen [Zahl der symmetrieunabhängigen Intensitäten: 1387, 1519 bzw. 1541; Zahl der beobachteten Reflexe mit $I_0 \ge 2\,\sigma(I)$: 1076, 1009 bzw. 964]. In allen Fällen wurde eine empirische Absorptionskorrektur mittels des Programms TAPER (Syntex XTL-System) nach Ausführung von ψ -scans an bis zu neun geeigneten Reflexen vorgenommen. Zur Ermittlung der Strukturparameter wurde ausgehend von denjenigen des Tl₄Ge₂S₆1, "kleinste Quadrate" — Verfeinerungen mit Hilfe der Programme FMLS und BLOCK ausgeführt. Die Verfeinerungen konvergierten nach mehreren Zyklen zu R-Werten von 0,060, 0,071 bzw. 0,098 [R_w mit $w=1/\sigma(F_0)$: 0,061, 0,058 bzw. 0,087] für Tl₄Si₂S₆, Tl₄Si₂Se₆ und Tl₄Ge₂Se₆.

Alle Rechnungen wurden auf einem NOVA-Kleinrechner mit Hilfe des XTL-Programmsystems (Syntex Analytical Instruments, Inc.) ausgeführt. Die in analytischer Darstellung benutzten Atomformfaktoren für die Atome und die Korrekturfaktoren für anomale Dispersion entsprechen den Angaben in den International Tables for X-ray Crystallography³.

Ergebnisse und Diskussion

Die Strukturparameter der neuen Verbindungen sind in Tabelle 2, die wichtigsten interatomaren Abstände in Tabelle 3 zusammengefaßt. Die untersuchten ternären Thalliumchalkogenide $Tl_4Si_2S_6$, $Tl_4Si_2Se_6$ und $Tl_4Ge_2Se_6$ sind mit $Tl_4Ge_2S_6^1$ isotyp und dementsprechend durch die mit $[Ge_2Se_6]^{4-}$ isoelektronischen Anionen $[Si_2S_6]^{4-}$, $[Si_2Se_6]^{4-}$ und $[Ge_2Se_6]^{4-}$ charakterisiert. Tl(1) ist von acht, Tl(2) von sieben S- bzw. Se-Atomen in asymmetrischer Anordnung (deformiert dodekaedrisch bzw. pentagonal bipyramidal) koordiniert¹.

Im $Tl_4Si_2S_6$ ist der mittlere Abstand Tl_S mit 3,371 Å fast identisch mit dem im $Tl_4Ge_2S_6$ mit 3,378 Å. Weder Thallium(I)thiosilikate noch das Anion $[Si_2S_6]^{4-}$ wurden bisher in der Literatur beschrieben. Der mittlere Abstand Si $_S$ ist mit 2,131 Å gegenüber dem Mittelwert Si $_S$ von 2,11 Å aus mehreren Strukturbestimmungen vergleichbarer Thiosilikate⁴ geringfügig vergrößert, jedoch fast identisch mit dem Abstand Si $_S$ (2,133 Å) im SiS_2^5 , das eine aus kantenverknüpften Tetraedern aufgebaute Kettenstruktur besitzt^{6,7}. Der zentrale planare Vierring des Anions $[Si_2S_6]^{4-}$ mit alternierenden Si- und S-Atomen ist auch aus Strukturbestimmungen molekularer Verbindungen wie $Si_2S_2Cl_4$ und $Si_2S_2Br_4$ bekannt⁵.

Mit $Tl_4Si_2Se_6$ konnte erstmals ein Thallium(I)selenosilikat dargestellt werden; auch das bitetraedrische Anion $[Si_2Se_6]^{4-}$ wird hier zum ersten Mal beschrieben. Der Bestand an Strukturdaten vergleichbarer Selenosilikate beschränkt sich auf diejenigen von $Pb_2SiSe_4^8$ mit dem mittleren Abstand Si—Se von 2,27 Å, der mit dem entsprechenden Mittelwert aus $Tl_4Si_2Se_6$ (2,273 Å) und der Bindungslänge Si—Se aus dem mit SiS_2 isotypen $SiSe_2^{9.5}$ (2,275 Å) sehr gut übereinstimmt.

Im Thallium(I)selenogermanat $Tl_4Ge_2Se_6$ beträgt der mittlere Abstand Ge—Se 2,357 Å und ist damit mit demjenigen aus $Tl_4Ge_4Se_{10}$ mit adamantanähnlich aufgebautem Anion $[Ge_4Se_{10}]^{4-10}$ identisch. Das bitetraedrische Anion $[Ge_2Se_6]^{4-}$ wurde hier erstmals in einem wasserfreien Selenogermanat nachgewiesen. Unabhängig von der vorliegenden Arbeit konnte dieses Anion auch im Natriumselenogermanathydrat $Na_4Ge_2Se_6\cdot 16H_2O$ von Krebs und $M\ddot{u}ller^{11}$ durch Röntgenstrukturanalyse identifiziert werden. Die mittleren Abstände Tl—Se betragen 3,458 Å für $Tl_4Si_2Se_6$ und 3,461 Å für $Tl_4Ge_2Se_6$ und sind damit

Tabelle 2. Strukturparameter der Verbindungen Tl₄Si₂Se, Tl₄Si₂Se₆ und Tl₄Ge₂Se₆ (Standardabweichungen in Klammern). Relative Ortsparameter × 104. Die anisotropen Temperaturfaktoren B_{ii} [Å²] sind definiert für: $\exp [-1/4 (B_{11} h^2 a^{*2} + B_{22} h^2 b^{*2} + B_{33} h^2 c^{*2} +$

	x	y	ю	B_{11}	B_{22}	B_{33}	B_{12}	B_{13}	B_{23}
$\mathrm{Tl}_4\mathrm{Si}_2\mathrm{S}_6$									
Tl(1)	1131,6(20)	9387,2(25)	3272,9(16)	2,84(5)	2,15(8)	2,82(6)	0,69(5)	1,09(5)	0,13(5)
T1(2)	2607,0(19)	6872, 5(25)	8908,9(15)	2,54(5)	3,08(8)	1,60(4)	1,04(5)	0,60(4)	0,59(4)
5 <u>7</u>	4313(11)	5455(14)	3219(8)	1,5(2)	1,6(4)	1,1(2)	0.6(3)	0.4(2)	0.2(2)
x (2)	2500(10)	4.781(14)	4 963 (8)	1,5(2)	2.8(4)	$\frac{1,8}{2}$	1,3(3)	0,8(4)	0.7(3)
00 (K 00 (K	$2501 (11) \\ 4870 (12)$	3036(12) 1282(14)	$1011(7) \ 7243(9)$	3,4 (3)	$0.4(3) \\ 1.4(4)$	0.0(2) 2.1(3)	0.3(2)	-0.1(2) $1.0(3)$	-0.5(2) 1.1(3)
) 5 E									•
$1.1_4\mathrm{S1}_2\mathrm{Se}_6$									
T1 (1)	1133(3)	9376(3)	3306(2)	3,01(7)	2,58(7)	2,51(7)	0.59(5)	0,90(5)	0.21(5)
T1(2)	2574(3)	6777(3)	8956(2)	2,60(6)	3,21(7)	1,16(5)	0,92(6)	0,35(5)	0,46(5)
	4329(15)	5488(15)	3201(11)	1,3(4)	1,3(4)	0,7(3)	0,6(3)	0.2(3)	-0.1(3)
Se(1)	2383(6)	4772(6)	4950(4)	1,4(1)	2,9(2)	1,0(1)	1,2(1)	0.4(1)	0,7(1)
Se(2)	2361(6)	2879(6)	932 (4)	2,5(1)	1,3(1)	0.2(1)	0.2(1)	-0.1(1)	-0.5(1)
Se(3)	4779(6)	1166(6)	7303(5)	2,7(2)	1,5(1)	1,6(1)	0.8(1)	0.6(1)	0.6(1)
${ m Tl_4Ge_2Se_6}$									
Tl(1)	1 161 (5)	9393(4)	3322(3)	2,7(1)	3,6(1)	3,4(1)	0,2(1)	0,3(1)	0,4(1)
$T^{1}(2)$	2528(4)	6775(4)	8940(3)	2,3(1)	4,2(1)	2,1(1)	0.1(1)	0.0(1)	1,0(1)
Ge	4311(9)	5477(9)	3131(6)	1,1(2)	2,5(2)	1,4(2)	0,0(2)	-0.1(2)	0.5(2)
Se(1)	2271(9)	4710(10)	4951(7)	0.8(2)	4,3(3)	2,1(2)	1,0(2)	0.3(2)	0,7(2)
$\operatorname{Se}\left(2 ight)$	2295(10)	2781(9)	828(6)	2,2(2)	2,7(3)	1,6(2)	0.4(2)	0,1(2)	0,1(2)
Se(3)	4793(11)	1048(9)	7354(7)	2,9(3)	2,2(2)	2,8(3)	0.2(2)	0.3(2)	1,1(2)

offenbar wegen der kleineren Koordinationszahlen der Tl-Atome gegenüber dem entsprechenden Mittelwert im ${\rm Tl_4Ge_4Se_{10}}$ (Neunerkoordination der Tl-Atome) mit 3,538 10 deutlich reduziert, sprechen jedoch auch hier für das Vorliegen von ${\rm Tl^+}$ -Ionen.

Tabelle 4 enthält eine Zusammenstellung von aus zwei kantenverknüpften Tetraedern aufgebauten isoelektronischen Thio- und Seleno-Anionen mit Elementen der vierten sowie der dritten und der fünften Hauptgruppe als Zentralatome. Der beschriebene Anionentyp wurde erstmals von Krebs, Pohl und Schiwy¹² in den aus wäßriger Lösung isotypen $Na_4Ge_2S_6 \cdot 14H_2O$ synthetisierten Salzhydraten $Na_4Sn_2S_6 \cdot 14 H_2O$ aufgefunden. Das Anion $[Ge_2S_6]^{4-}$ konnte im Gegensatz zu [Sn₂S₆]⁴⁻ auch in einer wasserfreien Verbindung, nämlich Tl₄Ge₂S₆¹, nachgewiesen werden. Das Anion [Sn₂Se₆]⁴⁻ wurde kürzlich als Bauelement des Thallium(I)selenostannats Tl₄Sn₂Se₆, das mit Tl₄Ge₂S₆ jedoch nicht isotyp ist, erkannt¹³, desgleichen das ebenfalls bitetraedrische Anion $[In_2S_6]^{6-}$ als Bauelement von $Rb_6In_2S_6^{14}$. Das Anion [P₂S₆]²⁻ tritt im Ag₂P₂S₆¹⁵ sowie zusammen mit anderen Thiophosphat-Anionen im Zn₄(P₂S₆)₃ ¹⁶ und im Ti₄P₈S₂₉ ¹⁷ auf. Auch in den ternären Übergangsmetalloxiden K₆Fe₂O₆ und K₆Mn₂O₆ liegen als kantenverknüpften Tetraeder ausgebildete Baugruppen $[M_2O_6]$ mit M = Fe, Mn vor¹⁸. In den isotypen ternären Chalkogenoferraten Na₆Fe₂S₆ und Na₆Fe₂Se₆ konnten Müller und Bronger¹⁹ ebenfalls isolierte [Fe₂S₆]⁶⁻- bzw. [Fe₂Se₆]⁶⁻-Anionen des beschriebenen Typs nachweisen. Für die bitetraedrischen Anionen mit Übergangsmetallen als Zentralatome sind jedoch andere Bindungsverhältnisse als im Falle der Hauptgruppenelemente anzunehmen.

Die aufgezählten bitetraedrischen Thio- und Selenoanionen mit Hauptgruppenelementen weisen charakteristische gemeinsame Strukturmerkmale auf (Tab. 4), die auch für die ebenfalls isoelektronischen dimeren Halogenide von Aluminium, Gallium und Indium des Formeltyps M_2X_6 zutreffen²⁰. Im zentralen, stets planaren Vierring, der aus den im Zentrum der Tetraeder befindlichen Atome (E) und den diese verbrückenden Chalkogenatomen (X_h) aufgebaut ist, erfolgt eine Annäherung der Bindungswinkel an 90°, wobei die Winkel X_b —E— X_b bei starker Abweichung vom idealen Tetraederwinkel stets > 90°, die Winkel $E - X_b - E$ zwangsläufig stets $< 90^{\circ}$ sind. Die Winkel $X_e - E - X_e$ (X_e : endständiges Chalkogenatom) andererseits sind im Vergleich zum idealen Tetraederwinkel mit einer Ausnahme (Tab. 4) beträchtlich aufgeweitet. Die Abstände $E-X_e$ erscheinen in allen Fällen gegenüber den Abständen E— X_b verkürzt, und zwar im Vergleich zu anderen Thio- und Selenoanionen mit Elementen der vierten und fünften Hauptgruppe besonders ausgeprägt^{10, 21}. Insbesondere bei den Anionen $[Si_2X_6]^{4-}$ (X = S, Se) und $[P_2S_6]^{4-}$ besteht auch eine

$$\label{eq:continuous_section} \begin{split} \text{Tabelle 3. Interatomare Abstände $[\mathring{A}]$ und $Valenzwinkel $[\mathring{\circ}]$ in $Tl_4Si_2S_6$, $Tl_4Si_2Se_6$ und $Tl_4Ge_2Se_6$ (Standardabweichungen in $Klammern)^a$ \end{split}$$

1. Tl ₄ Si ₂ S ₆			
Si—S (1) Si—S (1 ^{vi}) Si—S (2) Si—S (3 ^{vi}) Si—Si ^{vi}	2,176 (11) 2,174 (11) 2,070 (9) 2,102 (12) 2,917 (10)	$\begin{array}{l} S(1) \longrightarrow S(1^{vi}) \\ S(1) \longrightarrow S(2) \\ S(1) \longrightarrow S(3^{vi}) \\ S(1^{vi}) \longrightarrow S(2) \\ S(1^{vi}) \longrightarrow S(3^{vi}) \\ S(2) \longrightarrow S(3^{vi}) \end{array}$	3,226 (12) 3,503 (9) 3,516 (12) 3,535 (9) 3,487 (11) 3,529 (11)
$S(1)$ — Si — $S(1^{vi})$ S(1)— Si — $S(2)S(1)—Si—S(3^{vi})S(1^{vi})—Si—S(2)$	95,8 (4) 111,2 (5) 110,5 (5) 112,8 (5)	$\begin{array}{l} S\left(1^{vi}\right) \longrightarrow Si \longrightarrow S\left(3^{vi}\right) \\ S\left(2\right) \longrightarrow Si \longrightarrow S\left(3^{vi}\right) \\ Si \longrightarrow S\left(1\right) \longrightarrow Si^{vi} \end{array}$	109,3 (5) 115,6 (5) 84,2 (4)
$\begin{array}{c} Tl (1) - S (3^{vi}) \\ Tl (1) - S (2^{ii}) \\ Tl (1) - S (3^{ii}) \\ Tl (1) - S (2^{iv}) \\ Tl (1) - S (1^{ii}) \\ Tl (1) - S (1^{v}) \\ Tl (1) - S (1) \\ Tl (1) - S (1) \\ Tl (1) - Tl (1^{viii}) \\ Tl (1) - Tl (2^{v}) \end{array}$	3,055 (9) 3,159 (7) 3,200 (7) 3,437 (6) 3,488 (8) 3,660 (8) 3,663 (8) 3,726 (9) 3,942 (2) 3,936 (2)	Tl (2)—S (3 ^{vii}) Tl (2)—S (2 ⁱⁱⁱ) Tl (2)—S (2 ^{vi}) Tl (2)—S (3 ⁱⁱ) Tl (2)—S (2 ^v) Tl (2)—S (1 ^v) Tl (2)—S (1)	3,009 (7) 3,101 (7) 3,230 (8) 3,330 (8) 3,471 (8) 3,497 (7) 3,545 (7)
2. $Tl_4Si_2Se_6$ Si-Se(1) $Si-Se(1^{vi})$ Si-Se(2) $Si-Se(3^{vi})$ $Si-Si^{vi}$	2,314 (11) 2,320 (11) 2,230 (9) 2,221 (10) 3,092 (12)	$\begin{array}{l} \text{Se (1)} & - \text{Se (1^{vi})} \\ \text{Se (1)} & - \text{Se (2)} \\ \text{Se (1)} & - \text{Se (3^{vi})} \\ \text{Se (1^{vi})} & - \text{Se (2)} \\ \text{Se (1^{vi})} & - \text{Se (3^{vi})} \\ \text{Se (2)} & - \text{Se (3^{vi})} \end{array}$	3,452 (6) 3,723 (5) 3,743 (6) 3,768 (5) 3,733 (6) 3,761 (5)
$\begin{array}{l} {\rm Se}(1) {\longrightarrow} {\rm Si} {\longrightarrow} {\rm Se}(1^{\rm vi}) \\ {\rm Se}(1) {\longrightarrow} {\rm Si} {\longrightarrow} {\rm Se}(2) \\ {\rm Se}(1) {\longrightarrow} {\rm Si} {\longrightarrow} {\rm Se}(3^{\rm vi}) \\ {\rm Se}(1^{\rm vi}) {\longrightarrow} {\rm Si} {\longrightarrow} {\rm Se}(2) \end{array}$	96,3 (4) 110,0 (4) 111,2 (4) 111,8 (4)	$\begin{array}{l} \operatorname{Se}\left(1^{\operatorname{vi}}\right) & -\operatorname{Si} & -\operatorname{Se}\left(3^{\operatorname{vi}}\right) \\ \operatorname{Se}\left(2\right) & -\operatorname{Si} & -\operatorname{Se}\left(3^{\operatorname{vi}}\right) \\ \operatorname{Si} & -\operatorname{Se}\left(1\right) & -\operatorname{Si}^{\operatorname{vi}} \end{array}$	110,6 (4) 115,4 (5) 83,7 (4)
$\begin{array}{c} Tl\left(1\right) - Se\left(3^{vi}\right) \\ Tl\left(1\right) - Se\left(2^{ii}\right) \\ Tl\left(1\right) - Se\left(3^{ii}\right) \\ Tl\left(1\right) - Se\left(2^{iv}\right) \\ Tl\left(1\right) - Se\left(1^{ii}\right) \\ Tl\left(1\right) - Se\left(1^{v}\right) \\ Tl\left(1\right) - Se\left(1^{v}\right) \\ Tl\left(1\right) - Se\left(1\right) \\ Tl\left(1\right) - Tl\left(1\right) \\ Tl\left(1\right) - Tl\left(2^{v}\right) \\ Tl\left(1\right) - Tl\left(1^{viii}\right) \end{array}$	3,204 (5) 3,247 (6) 3,310 (4) 3,493 (6) 3,600 (4) 3,679 (4) 3,758 (5) 3,760 (4) 3,965 (3) 4,042 (3)	Tl (2)—Se (3 ^{vii}) Tl (2)—Se (2 ⁱⁱⁱ) Tl (2)—Se (2 ^{vi}) Tl (2)—Se (3 ⁱⁱ) Tl (2)—Se (2 ^v) Tl (2)—Se (1 ^v) Tl (2)—Se (1)	3,072 (4) 3,180 (4) 3,358 (5) 3,388 (4) 3,531 (5) 3,578 (4) 3,684 (4)

Tabelle 3 (Fortsetzung)

3. $Tl_4Ge_2Se_6$			
Ge—Se (1)	2,422(9)	Se (1)—Se (1 ^{vi})	3,600 (10)
Ge—Se (1 ^{vi})	2,408(9)	Se (1)—Se (2)	3,851(8)
Ge—Se (2)	2,287(7)	$\operatorname{Se}\left(1\right)$ — $\operatorname{Se}\left(3^{\operatorname{vi}}\right)$	3,878(9)
Ge—Se (3v1)	2,312(8)	Se (1 ^{vi})—Se (2)	3,896(8)
$Ge-Ge^{vi}$	3,221(7)	$\operatorname{Se}(1^{\operatorname{vi}})$ — $\operatorname{Se}(3^{\operatorname{vi}})$	3,876(9)
		$\operatorname{Se}(2)$ — $\operatorname{Se}(3^{\operatorname{vi}})$	3,911(8)
Se (1)—Ge—Si (1 ^{vi})	96,4(3)	Se (1 ^{vi})—Ge—Se (3 ^{vi})	110,4(3)
Se (1)—Ge—Se (2)	109,7(3)	Se (2)—Ge—Se (3 ^{vi})	116,5(3)
$Se(1)$ — Ge — $Se(3^{vi})$	109,9(3)	$Ge-Se(1)-Ge^{vi}$	83,6(3)
$Se(1^{vi})$ — Ge — $Se(2)$	112,1(3)		
$Tl(1)$ — $Se(3^{vi})$	3,196 (9)	$\mathrm{Tl}\left(2\right)$ —Se $\left(3^{\mathrm{vii}}\right)$	3,077(6)
$Tl(1)$ —Se (2^{ii})	3,278(6)	$\mathrm{Tl}\left(2\right)$ —Se $\left(2^{\mathrm{i}\mathrm{i}\mathrm{i}}\right)$	3,217(6)
Tl (1)—Se (3 ⁱⁱ)	3,345(6)	Tl(2)—Se(3 ⁱⁱ)	3,317(6)
$\mathrm{Tl}\left(1\right)$ —Se $\left(2^{\mathrm{i}\mathrm{v}}\right)$	3,434(5)	$Tl(2)$ —Se (2^{vi})	3,398(8)
$Tl(1)$ — $Se(1^{ii})$	3,603(7)	$Tl(2)$ —Se(1 v)	3,545(6)
$Tl(1)$ —Se(1 v)	3,627(7)	Tl (2)—Se (2 ^v)	3,555(8)
Tl(1)—Se(1)	3,811(7)	Tl (2)—Se (1)	3,683(6)
$Tl(1)$ —Se(3 v)	3,822(9)		
Tl(1)— $Tl(2v)$	3,980(4)		
Tl(1)— $Tl(1viii)$	4,061 (4)		

^a Die Transformationen der Ortsparameter werden wie folgt bezeichnet:

starke Verkürzung des Abstandes X_b — X_b gegenüber der Summe der van der Waalsschen Radien der X_b -Atome (2 $r_{\mathrm{S}^2}=3.68\,\mathrm{\mathring{A}}$, 2 $r_{\mathrm{S}^2}=3.96\,\mathrm{\mathring{A}}^{22}$). Auf Grund der stets vorhandenen Kontraktion der Winkel X_b —E— X_b , aber auch auf Grund der Verkürzung der Abstände X_b — X_b im zentralen Vierring muß ein mehr oder weniger ausgeprägter Spannungszustand dieses Vierringes angenommen werden. Die von Krebs, Pohl und $Schiwy^{12}$ gegebene Interpretation der Bindungsverhältnisse erscheint auch bei Berücksichtigung der neueren Strukturdaten plausibel mit der Ergänzung, daß die nichtbindende Wechselwirkung der Chalkogenatome im Vierring insbesondere mit Silizium bzw. Phosphor als Zentralatome mit berücksichtigt werden muß.

Der Autor dankt Herrn Professor $B.\,Krebs$ für die Überlassung unveröffentlichter Daten.

Tabelle 4. Strukturdaten bitetraedrischer Thio- und Selenoanionen mit Haupt-

Anion	Verbindung	Lit.	$\overline{d}\left(E-X ight)$	$\overline{d} (E - X_b)$	$\overline{d} (E-X_e)$
$\begin{array}{c} [\mathrm{Si}_2\mathrm{S}_6]^{4-} \\ [\mathrm{Si}_2\mathrm{Se}_6]^{4-} \\ [\mathrm{Ge}_2\mathrm{S}_6]^{4-} \\ [\mathrm{Ge}_2\mathrm{Se}_6]^{4-} \\ [\mathrm{Ge}_2\mathrm{Se}_6]^{4-} \\ [\mathrm{Se}_2\mathrm{Se}_6]^{4-} \\ [\mathrm{Sn}_2\mathrm{Se}_6]^{4-} \end{array}$	$\begin{array}{c} {\rm Tl_4Si_2S_6} \\ {\rm Tl_4Si_2Se_6} \\ {\rm Tl_4Ge_2S_6} \\ {\rm Na_4Ge_2S_6} \cdot 14 \ {\rm H_2O} \\ {\rm Tl_4Ge_2Se_6} \\ {\rm Na_4Ge_2Se_6} \cdot 16 \ {\rm H_2O} \\ {\rm Na_4Sn_2S_6} \cdot 14 \ {\rm H_2O} \end{array}$	d. A. d. A. (1) (12) d. A. (11) (12)	2,131 2,273 2,219 2,221 2,357 2,361 2,391	2,175 2,317 2,275 2,272 2,415 2,417 2,450	2,086 2,226 2,164 2,170 2,300 2,306 2,332
$\begin{array}{l} [\mathrm{Sn}_2\mathrm{S}_6]^4 \\ [\mathrm{Sn}_2\mathrm{Se}_6]^4 - \\ [\mathrm{In}_2\mathrm{S}_6]^6 - \\ [\mathrm{P}_2\mathrm{S}_6]^2 - \\ [\mathrm{P}_2\mathrm{S}_6]^2 - \\ [\mathrm{P}_2\mathrm{S}_6]^2 - \\ [\mathrm{P}_2\mathrm{S}_6]^2 - \end{array}$	$egin{array}{l} Na_4 Sn_2 Se_6 & Fil_4 Sn_2 Se_6 & Fil_4 Sn_2 Se_6 & Fil_4 Fil$	(12) (13) (14) (16) (15) (17)	2,553 2,473 2,058 2,057 2,055	2,596 2,533 2,119 2,122 2,113	2,532 2,511 2,413 1,996 1,994 1,996

a Bindungskontraktion $\Delta d/d = [\overline{d}(E - X_b) - \overline{d}(E - X_e)]/[\overline{d}(E - X_b)] \cdot 100 [\%]$.

Literatur

- ¹ Eulenberger G., Acta Cryst. **B34**, 2614 (1978).
- ² Eulenberger G., Müller D., Z. Naturforsch. **29 b**, 118 (1974).
- ³ International Tables for X-Ray Crystallography, Vol. IV. Birmingham: The Kynoch Press. 1974.
- ⁴ Olivier-Fourcade J., Jumas J.-C., Ribes M., Philippot E., Maurin M., J. Solid State Chem. 23, 155 (1978).
- ⁵ Peters J., Mandt J., Meyring M., Krebs B., Z. Kristallogr. **156**, 91 (1981).
- ⁶ Zintl A., Loosen K., Z. phys. Chem. A 174, 301 (1935).
- ⁷ Büssen W., Fischer H., Gruner E., Naturwiss. 23, 740 (1935).
- ⁸ Iglesias J. E., Steinfink H., J. Solid State Chem. 6, 93 (1973).
- ⁹ Weiss A., Weiss A., Z. Naturforsch. 7b, 483 (1951).
- ¹⁰ Eulenberger G., Z. Naturforsch. **36 b**, 521 (1981).
- ¹¹ Krebs B., Müller H., persönliche Mitteilung.
- ¹² Krebs B., Pohl S., Schiwy W., Z. Anorg. Allg. Chem. **393**, 241 (1972).
- ¹³ Jaulmes S., Houenou P., Mat. Res. Bull. 15, 911 (1980).
- ¹⁴ Deiseroth H.-J., Z. Naturforsch. **35b**, 953 (1980).
- ¹⁵ Toffoli P., Khodadad P., Rodier N., Acta Cryst. **B34**, 3561 (1978).
- ¹⁶ Bouchetiere M., Toffoli P., Khodadad P., Rodier N., Acta Cryst. B34, 384 (1978).
- 17 Jandali M. Z., Eulenberger G., Hahn H., in Vorbereitung.
- ¹⁸ Rieck H., Hoppe R., Z. Anorg. Allg. Chem. 408, 151 (1974); Brachtel G., Hoppe R., Z. Anorg. Allg. Chem. 446, 64 (1978).
- ¹⁹ Müller P., Bronger W., Z. Naturforsch. 34 b, 1264 (1979); Z. Kristallogr. 156, 24 (1981).

gruppenelementen (Interatomare Abstände in Å, Bindungswinkel in °)

$\Delta d/d^{ m a}$	$\star X_b - E - X_b'$	$\star X_e - E - X_e'$	$\not < E - X_b - E'$	$d\left(X_{b}X_{b}\right)$	Punkt- symmetrie
4,1	95,8	115,6	84,2	3,226	1
3,9	96,6	115,1	83.4	$3,\!456$	1
4,9	95,0	116.8	85,0	3.350	1
4,5	93,9	117,1	86,1	3,321	1
4,8	96,4	116,5	83,6	3,600	1
4,6	95,4	114,6	84,6	3,576	1
4,8	94,0	119,8	86,0	3,584	1
3,3	92,8	110,5	87,2	3,761	\mathbf{m}
4,7	92,1	112,1	87.9	3,647	$2/\mathrm{m}$
5.8	94,1	112,0	85,9	3,102	$\dot{\mathbf{m}}$
6,0	93,7	118,0	86,3	3,094	2/m
5,5	93,9	107,3	86,1	3,087	$rac{2/\mathrm{m}}{1}$

Wells A. F., Inorganic Structural Chemistry, 4. Aufl., S. 356, 375. Oxford: Clarendon Press. 1975.

²¹ Jandali M. Z., Eulenberger G., Hahn H., Z. Anorg. Allg. Chem. 445, 184 (1978).

 $^{^{22}}$ Pauling L., The Nature of the Chemical Bond, 3. Aufl. Ithaca: Cornell University Press. 1960.